This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

2000-193807

(43)Date f publication of application: 14.07.2000

(51)Int.CI.

GO2B 5/02

GO2B 5/08 G02F 1/1335

(21)Application number: 10-370968

(71)Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

(22)Dat of filing:

25.12.1998

(72)Inventor:

MASUSHIGE KUNIO

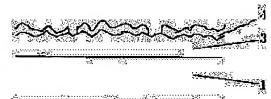
KEYAKIDA MASAYA

YOKOZUKA TOSHISUKE

(54) DIFFUSE REFLECTION PLATE, MANUFACTURE THEREOF, AND REFLECTION TYPE DISPLAY ELEMENT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain uniformity of diffused reflectivity and an xcellent diffuse reflection plate used for the display element of a r flection liquid crystal display element by forming a paint film having a rugged form on the surface of a substrate, forming a metallic thin film on the paint film, and forming rugged form on the surface of the metallic thin film to diffuse and reflect incidental light.

SOLUTION: A paint film 3 is formed rugged on a substrate 1 by applying a resin, a reflection electrode 4 of a metallic thin film is formed theron, and th m tallic thin film surface is made into a rugged form to diffuse and r fl ct incidental light. In this case, for the resin paint film, a composition having two components (a), (b) and solvent as essential components are us d. For desirable combination of (a), (b), a fluorocarbon resin having fluorin containing aliphatic ring constitution in main chain and partial hydrolysis condensate of alcoxylan shown by R1mR2nSi(OR3)4-(m+n) can be mentioned. Where R1, R2 are organic group of carbon number 1-14, R3 is alkyl group of carbon number 1-8, and m, n are integers satisfying m+n 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the xamin r's decision of rejection or application converted r gistration]

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Numb r of appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of requesting appeal against examiner's decision of r j ction]

[Dat of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Offic

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-193807

(P2000-193807A) (43)公開日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	· テーマコード(参考)
G 0 2 B	5/02	G 0 2 B	5/02 C 2H042
	5/08		5/08 A 2H091
			С
G 0 2 F	1/1335 5 2 0	G 0 2 F	1/1335 5 2 0
	5 3 0		5 3 0
	審査請求 未請求 請求項の数7	OL	(全9頁)
(21)出願番号	特願平10−370968	(71)出願人	00000044
			旭硝子株式会社
(22) 出願日	平成10年12月25日(1998.12.25)		東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
		(72)発明者	增茂 邦雄
		· ·	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
		·	旭硝子株式会社内
		(72) 発明者	學田 昌也
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
			旭硝子株式会社内
		(74)代理人	100080229
			弁理士 石田 康昌 (外1名)
			・ 最終頁に続く

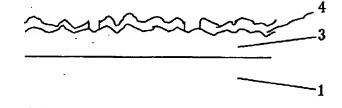
(54) 【発明の名称】拡散反射板とその製造方法および反射型表示素子

(57)【要約】

(37) 【安元 (37) 【安元 (37) 【理題】

【課題】反射型液晶表示素子等に使用可能で、生産性良く工業的に製造でき、均一な拡散反射性能に優れた拡散反射板、特に拡散反射電極に好適に適用できる拡散反射板を提供する。

【解決手段】表面に凹凸形状を有する塗膜3を基板1上に形成し、金属薄膜を当該塗膜3上に形成し金属薄膜表面を凹凸形状として入射光を拡散反射させるように構成し電極を兼ね備えると反射電極4が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】表面に凹凸形状を有する塗膜を基板上に形成し、金属薄膜を当該塗膜上に形成し金属薄膜表面を凹凸形状として入射光を拡散反射させるように構成した拡散反射板。

【請求項2】拡散反射電極である請求項1に記載の拡散 反射板。

【請求項3】当該塗膜が下記の(a) および(b) を含む組成物により形成されてなる請求項1または2に記載の拡散反射板:

(a) 主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂; および (b) 式 $R^1_mR^2_nS$ i (O R^3) $_{4-(m+n)}$ (式中 R^1 および R^2 は炭素数 $1\sim 1$ 4の有機基であり、互いに同じであっても異なっていてもよく、 R^3 は炭素数 $1\sim 8$ 0アルキル基であり、mおよびnは $m+n\leq 3$ を満たす $0\sim 3$ 0整数である。)で示されるアルコキシシランの部分加水分解縮合物。

【請求項4】当該組成物中の(a)と(b)の比率が(a)100重量部に対して(b)100重量部以上である請求項3に記載の拡散反射板。

【請求項5】当該塗膜の表面において、平面内の一方向における凹凸のピッチp が0.5~10.0 μ mで、凹凸の段差の高さの平均h が1.0~5.0 μ mである請求項1,2,3または4に記載の拡散反射板。

【請求項6】 塗膜材料を基板上に塗布し、この塗膜材料の状態を変えることで凹凸形状を有する塗膜を形成し、その上方に成膜により金属薄膜を形成し、金属薄膜表面を凹凸形状として入射光を拡散反射させるように構成した拡散反射板の製造方法。

【請求項7】請求項1、2、3、4または5に記載の拡 散反射板を使用した反射型表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子等と 組み合わせて用いられる拡散反射板、その製造方法およ びそれを使用した反射型表示素子に関する。この拡散反 射板は内面拡散用の反射板で、特に反射型液晶表示素子 等の表示素子の金属薄膜電極(拡散反射電極)にも適用 可能である。

【0002】特に、反射型液晶表示素子において入射光 を拡散反射させ、明るい白色表示を可能とし、また反射 板を液晶表示素子の内面に配置すると高精細な表示を可 能にする。

[0003]

【従来の技術】ノート型パソコン、携帯情報端末等、可 搬型の電子機器に液晶表示素子が多く使われるようにな った。これらの用途では電池駆動であるため、従来の透 過型液晶表示素子と比べ、より消費電力の低い反射型の 液晶表示素子が必要となり、その開発が進められてい る。反射型の液晶表示素子においては、明るく見える視 野角を広げ、また金属光沢ではない「白」表示を実現するため、入射光を散乱させるための層が素子のどこかに 必要となる。従来から、液晶表示素子のセルの外側に拡 散反射板を設ける方式によって反射型の液晶表示素子が 製造されている(従来例1)。

【0004】しかし、近年髙精細の表示素子が求められるようになってきた。従来例1では、基板に使用するガラスの板厚による視差があるため画素間で反射光が混合しコントラストの低下等を招き十分な画像品位が得られ10 ない。

【0005】一方、セル内面に反射電極を形成し表側基板の外側に光を散乱させるフィルム等を設ける方式も提案されているが、さらなる高精細化の要求に対しては十分ではない(従来例2)。

【0006】最近、セル内面の反射電極において、フォトマスクを用いたフォトリソグラフィーにより凹凸パターンを電極に形成し拡散反射電極を設けた反射型の液晶表示素子が提案されている。例えば、月刊LCD Intelligence 1998年1月号36頁参照(従来例3)。この従来例3によれば、高精細な反射型液晶表示素子を実現することができる。

[0007]

20

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来例3の凹凸パターンを平面方向に単純なくり返しパターンとすると反射電極が回折格子として作用することになり、表示を視認した際に虹色に発色したり、配線やブラックマトリクス等の他のくり返しパターンとの位置関係の微妙なずれによりいわゆるモアレ縞が見えたりといった表示上の不良を発生する恐れがある。そのため、凹凸パターン形成に用いるフォトマスクの設計においては通常の画素パターン形成のような単純なくり返しを用いることはできず、極めて煩雑で困難な設計を行なう必要がある。しかし、くり返しパターンとなることは避けられない。

【0008】また、フォトリソグラフィーの際にも、他のくり返しパターンとの位置関係の微妙なずれや、ステッパーを用いて分割露光をする場合には継ぎ目の微妙な位置ずれが表示素子として完成後視認される恐れがある。そのため製造においても厳しい精度管理が必要となる。このように、通常のフォトリソグラフィーにより適当な拡散能を持った反射電極を形成することは容易なことではない。そこで、高い生産性を維持しながらセル内面に何らかの光拡散機能を有する光拡散層を設けることが課題となっている。

【0009】また、スリガラスを通して感光性樹脂を露光してランダムな凹凸パターンを形成し、その上に金属薄膜を成膜し、拡散反射電極を形成する方法(特開平10-253977号公報参照。)が提案されているが、フォトリソグラフィーの工程を必要とし、しかも特殊なフォトリソグラフィーとなる。そのため、コスト的に不50利であり、さらに分割露光の継ぎ目の問題はより強調さ





れるものと考えられ、課題が残されている。従って、均一な拡散反射性能に優れた凹凸形状を有し、しかも工業的に容易に製造が可能で拡散反射電極にも適用できる拡散反射板の開発が求められている。

【0010】本発明の目的は、拡散反射能の均一性を確保し、反射型液晶表示素子等の表示素子に使用するのに適した優れた拡散反射板、特に拡散反射電極にも適用可能な拡散反射板、その製造方法およびそれを使用した表示素子を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明では、表面に凹凸形状を有する塗膜を基板上に形成するが、そのためには塗膜をガラス等の基板上に各種の塗布方法を用いて設けることができ、この場合、凹凸形状を有する塗膜としては有機および無機の塗膜が採用可能であるが、樹脂塗布により塗膜を形成するのが好ましい。その上に金属薄膜を成膜すると、容易にその金属薄膜表面を凹凸形状とし、入射光を拡散反射させるように構成することができる。その場合、樹脂塗膜には下記組成物を使用するのが好ましい。

【0012】尚、本発明においては前記塗膜形成による 塗膜表面の凹凸形状を利用して金属薄膜表面を凹凸形状 に構成するものであり、当該凹凸形状を利用する限りに おいて凹凸形状を有する塗膜層と金属薄膜層との間に当 該凹凸形状を維持する層や、当該凹凸形状の微調整を行 うための層等を必要により設けることができる。

【0013】本発明に使用する組成物としては、少なくとも(a) および(b) の二成分と溶剤を必須成分とする組成物を挙げることができ、(a)、(b) は同一の溶剤に溶解可能な互いに基本骨格の異なるポリマーまたはオリゴマーが好ましい。

【0014】この樹脂塗膜形成法によれば、この組成物を塗布して硬化させることにより、溶剤の揮発と(b)成分の硬化と共に(a)成分一(b)成分の硬化物間の相分離が発生し、その結果拡散反射板として特性の優れた凹凸形状を有する塗膜を形成することができるので、特に好ましい。

【0015】(a)、(b)の好ましい組み合わせとしては下記が例示できる。

(a) 主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂; および(b) 式 $R^1_mR^2_nSi$ (O R^3) $_{4-(m+n)}$ (式中、 R^1 および R^2 は炭素数 $1\sim 1$ 4 の有機基であり、互いに同じであっても異なっていてもよく、 R^3 は炭素

数1~8のアルキル基であり、mおよびnはm+n≦3 を満たす0~3の整数である。)で示されるアルコキシ シランの部分加水分解縮合物。

【0016】本発明に使用する前記成分(a)の主鎖に 脂肪族環構造を有するフッ素樹脂としては、2つ以上の 重合性二重結合を有する含フッ素モノマーを環化重合し て得られる主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素 樹脂、含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーを重合し て得られる主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素 りでである主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素 が脂、これら2種のモノマーを共重合させて得られるフッ素樹脂、これら2種のモノマーの少なくとも1種とそれら以外のモノマーとを共重合させて得られるフッ素樹脂等が挙げられる。

【0017】主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するとは、脂肪族環を構成する炭素原子の1以上が主鎖を構成する炭素連鎖中の炭素原子であり、かつ脂肪族環を構成する炭素原子の少なくとも一部にフッ素原子またはフッ素含有基が結合している構造を有していることを意味する。

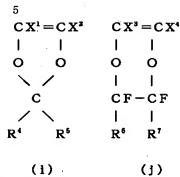
20 【0018】2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ 素モノマーとしては、下記の式(e)、式(f)、式 (g)または式(h)で示されるものが例示される。但 し、式(e)~式(h)中のT¹~T¹²、Y¹~Y¹°、Z ¹~Z°およびW¹~W°は、それぞれ独立に下またはC F3である。

【0019】含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーとしては、下記の式(i)、式(j)または式(k)で示されるものが例示される。但し、式(i)~式(k)中の X^1 ~ X^6 はそれぞれ独立に下または CF_3 であり、 R^4 ~ R^9 はそれぞれ独立に下、 C_nF_{2n+1} 、または $C_nF_{2n+1-p}H_pO_q$ であり、ここでnは $1\sim5$ の整数、pは0~5の整数、qは0~2の整数であり、または、 R^4 ~ R^9 はそれぞれ独立してアルキレン基またはフルオロアルキレン基であって、かつ R^4 と R^5 、 R^6 と R^7 、 R^8 と R^9 が連結して環を形成していてもよい。

[0020] (e) $CT^{1}T^{2}=CT^{3}CT^{4}T^{5}CT^{6}T^{7}$ $CT^{3}T^{9}CT^{10}=CT^{11}T^{12}$;

 $(f) \cdot CY^{1}Y^{2} = CY^{3}OCY^{4}Y^{5}CY^{6}Y^{7}CY^{8} = CY^{9}Y^{10}$:

- 40 (g) $CZ^{1}Z^{2}=CZ^{3}OCZ^{4}Z^{5}CZ^{6}=CZ^{7}Z^{8}$;
 - (h) $CW^1W^2 = CW^3OCW^4W^5OCW^6 = CW^7W^8$; [0021]



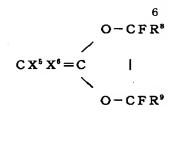
【0022】2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ素モノマーを環化重合して得られる主鎖に脂肪族環構造を有するフッ素樹脂は、特開昭63-238111号、特開昭63-238115号、特開平7-316235号公報等において公知である。例えば、ペルフルオロ(アリルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ブテニルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ビス(ビニルオキシ)メタン)等のモノマーを単独重合、またはこれらのモノマーとラジカル重合性モノマーを共重合して得られるフッ素樹脂を使用することができる。

【0023】ラジカル重合性モノマーとしては、好ましくはエチレン等のオレフィン類、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン等のペルフルオロオレフィン類およびペルフルオロ(ブチルビニルエーテル)等のペルフルオロ(アルキルビニルエーテル)類等の中から、例えは1種または2種以上を選択することができる。

【0024】また、含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーを重合して得られる主鎖に脂肪族環構造を有するフッ素樹脂は、特公昭63-18964号、特開平7-70107号公報等において公知である。例えば、ペルフ30ルオロ(2,2-ジメチル-1,3-ジオキソール)、2,2,4-トリフルオロ-5-トリフルオロメトキシー1,3-ジオキソール等の含フッ素環構造を有するモノマーを単独重合、または、これらのモノマーと上記ラジカル重合性モノマーを共重合して得られるフッ素樹脂を使用することができる。

【0025】また、ペルフルオロ(2,2ージメチルー1,3ージオキソール)、2,2,4ートリフルオロー5ートリフルオロメトキシー1,3ージオキソール等の含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーとペルフルオロ(アリルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ブテニルビニルエーテル)、ペルフルオロ(ビスビニルオキシメタン)等の2つ以上の重合性二重結合を有する含フッ素モノマーを共重合して得られるフッ素樹脂を使用することもできる。

【0026】主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂としては、フッ素樹脂の繰り返し単位中に含フッ素脂肪族環構造を $20\sim100$ モル%程度含有するものが機械的特性等の面から好ましく、重量平均分子量については、特に限定されないが、 $3,000\sim1000$,



(k)

000程度が好ましく、5,000~500,000程度がより好ましい。

【0027】本発明において使用する成分(b)としては、前述の通り式 $R_n^1 R^2 S$ i(OR^3)4-(m+n)で示されるアルコキシシランの部分加水分解縮合物を使用することができる。

【0028】この式中において、R¹およびR²は炭素数 1~14の有機基であり、互いに同じであっても異なっていてもよく、R³は炭素数1~8のアルキル基、mおよびnはm+n≤3を満たす0~3の整数である。R¹およびR²としてはそれぞれ独立していて、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の脂肪族アルキル基、フェニル基、トリル基等のアリール基、トリフルオロメチル基、トリフルオロプロピル基、ペンタフルオロブチル基、ノナフルオロヘキシル基、トリデカフルオロオクチル基、ヘプタデカフルオロデシル基、ヘプタデカフルオロウンデシル基等の含フッ素アルキル基等が好ましい。

【0029】式中のR³としては、メチル基、エチル

基、プロピル基、ブチル基等のアルキル基が好ましい。 【0030】このようなアルコキシシランの好ましい例 としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン等のテトラアルコキシシラン類、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン等のモノアルキルトリアルコキシシラン類、トリフルオロメチルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、イナフルオロアルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロウンデシルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロウンデシルトリメトキシラン、ヘプタデカフルオロウンデシルトリメトキシラン、ヘプタデカフルオロウンデシルトリメトキシラン等のフルオロアルキルアルコキシシラン類を挙げるこ

【0031】これらのアルコキシシランは、単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。2種以上を併用する場合には、フルオロアルキルアルコキシシラン類とフッ素を含まないアルコキシシラン(特に、テトラアルコキシシランが好ましい。)との併用が好ましい。ま50 た、フルオロアルキルアルコキシシラン類は後述するフ

とができる。

50

ッ素溶剤への溶解性が高いため好適に用いられる。

【0032】これらのアルコキシシランの縮合反応は、 周知、公知の方法により行うことができる。例えば、ア ルコキシシランを溶媒および触媒の存在下に水を添加し て加水分解縮合反応させる方法がある。この場合、必要 に応じて加熱を行ってもよい。触媒としては塩酸、硝 酸、硫酸等の無機酸、ギ酸、シュウ酸、酢酸等の有機酸 が使用できる。通常、生成物の分子量をポリスチレン換・ 算重量平均分子量で500~10000程度の範囲に設 定するのが、後述する溶剤への溶解性の観点から好まし い。次いで必要に応じて系内に存在する水を蒸留等によ り除去し、さらに触媒をイオン交換樹脂等で除去しても

【0033】本発明において、成分(a)と(b)の混 合溶液を調製するに当たり、溶剤としてこれらを同時に 溶解せしめるものを選択することが重要である。

【0034】例えば特開平7-112126号公報に記 載のような、非プロトン性含フッ素溶剤とプロトン性含 フッ素溶剤の混合物が例示される。ここで特徴的なの は、主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂 (a) は非プロトン性フッ素溶剤には溶解するが、プロ トン性含フッ素溶剤には溶解せず、逆に部分加水分解縮 合物(b)は、プロトン性含フッ素溶剤には溶解する が、非プロトン性含フッ素溶剤には溶解しない場合があ り、従って混合溶剤にすることにより両者を同時に溶解 するという点である。

【0035】非プロトン性含フッ素溶剤とは、通常の反 応条件下では解離せずプロトンを生じない含フッ素溶剤 であり、公知、周知のものが使用できる。ペルフルオロ デカリン、ペルフルオロシクロヘキサン、ペルフルオロ ヘキサン、ペルフルオロオクタン、1H, 1H, 1H, 2H, 2H-ペルフルオロオクタン、1H, 1H, 1 H, 2H, 2H-ペルフルオロデカン等の含フッ素脂肪 族炭化水素類、ペルフルオロトリペンチルアミン、ペル フルオロトリブチルアミン、ペルフルオロトリプロピル アミン等の含フッ素アルキルアミン類、ペルフルオロ (2-ブチルテトラヒドロフラン) 等の含フッ素環状エ ーテルが例示される。これらを2種以上混合して使用し てもよい。

【0036】プロトン性含フッ素溶剤とは解離してプロ トンを生じやすい含フッ素溶剤であり、公知、周知のも のが使用できる。CF₃CH₂OH、CF₃CF₂CH₂O $H, CF_3 (CF_2)_3 CH_2 CH_2 OH, CF_3 (CF_2)_5$ CH2CH2OH, CF3CF2CH2CH2CH2OH, C F₃ (CF₂)₃CH₂CH₂CH₂OH等の含フッ素アルコ ールが好適に例示される。これらを2種以上併用しても

【0037】全溶剤組成を決定するに当たっては、当然 のことながら主鎖に脂肪族環構造を有するフッ素樹脂と アルコキシシランの部分加水分解縮合物両者の溶解性を 損なわない範囲に設定する必要がある。この観点より、 通常、非プロトン性含フッ素溶剤:プロトン性含フッ素 溶剤=99:1~60:40 (重量比)、さらには9 8:2~70:30 (重量比) の範囲に設定するのが好 ましい。

【0038】また、アルコキシシランの部分加水分解縮 合物がフルオロアルキルアルコキシシラン類を含有する 場合、その組成によっては非プロトン性含フッ素溶剤に 溶解するので、その場合プロトン性含フッ素溶剤の添加 は必要ないか、或いは1重量%以下の極少量の添加で均 一な混合溶液を調製できることがある。

【0039】成分(a)と(b)の組成比については、 必要とされる釜膜の凹凸形状に応じて任意の割合に設定 することができるが、成分(a) 100重量部に対し て、好ましくは成分(b)を100重量部以上、より好 ましくは100~900重量部程度、さらに好ましくは 150~400重量部配合するとよい。

【0040】(a)と(b)を混合した溶液中での固形 分濃度は、それが溶解する範囲で、所望の溶液粘度また 20 は塗膜の膜厚等の観点から適宜選択すればよい。例え ば、膜厚0.1~5μmの塗膜をスピンコート法にて得 ようとする場合、一般には固形分濃度を1~15重量%、 に設定すればよい。

【0041】本発明に使用する組成物には(a)、

(b) 以外の成分として、目的に応じて接着性向上剤、 界面活性剤等の添加剤を配合できる。

【0042】また、この組成物により、基板上に当該塗 膜を作成する方法としては、溶剤を含む前記の組成物を 基板に塗布した後に、加熱乾燥して溶剤を揮発させる方 法が好ましく採用される。この際、下地との十分な密着 性を確保するために、下地表面をシランカップリング剤 等のカップリング剤で処理してもよい。

【0043】この組成物の塗布方法としては、スピンコ ート法、ディッピング法、ポッティング法、ダイコート 法、スプレーコート法等が例示され、塗布の対象である 基板の形状、必要膜厚等から適宜選択すればよい。膜厚 の面内分布の均一性からスピンコート法およびダイコー ト法が好ましい。

40 せ、(a)成分-(b)成分間の相分離による凹凸形状 を形成するために塗布後のベーク工程を要する。ベーク 条件は、塗膜厚等により適宜選択すればよいが、通常2 00~350℃程度の最終ベークが必要である。アルコ キシシランの部分加水分解縮合物(b)を十分に硬化さ せるという観点からもベークが必要であり、未反応のア ルコキシシリル基或いはシラノール基が残存しないよう にするには、好ましくは200℃、より好ましくは25 0℃以上の最終ベークが必要である。未反応のアルコキ シシリル基或いはシラノール基は、それ自体が塗膜の絶 縁特性を低下させる原因となり、さらには吸水部位とな

り得るために、水による電気特性の劣化を防止する意味 でも塗膜中にできるだけ残存しないことが望ましい。

【0045】塗膜の相分離構造を制御する、或いは塗膜の断差平坦化性を向上させる等の目的で、50~150 ℃程度のプリベーク工程を追加したり、ベーク工程を何 段階かに分けて実施することもできる。

【0046】当該塗膜上に形成する反射板構成のための 金属薄膜の成膜については、従来から反射板として採用 される金属薄膜用の材料を用いてその成膜方法として知 られている方法により成膜するとよい。金属薄膜による 拡散反射電極を構成する場合には、金属薄膜電極として 使用できる材料を用いて、金属薄膜の成膜法として知ら れている方法により成膜するとよい。特に、前記組成物 を使用して形成された凹凸形状を有する前記塗膜の上に 金属薄膜を成膜すると、金属薄膜表面を凹凸形状にして 入射光を均一に拡散反射させるように構成することがで きる。

【0047】本発明の拡散反射板は、基板上に塗膜材料を塗布し、この塗布された材料の状態を変えることで、 凹凸形状を有する塗膜を形成し、その上方に金属薄膜を 形成し、金属薄膜表面を凹凸形状として入射光を拡散反 射させるように構成することにより製造することがで き、この方法も本発明に含まれる。

【0048】前記組成物を塗膜材料として基板上に塗布すると、形成される塗膜の材料の状態が変化して前記凹凸形状を有する塗膜を形成することができる。その上方に金属薄膜を成膜すると、この金属薄膜表面に目的とする凹凸形状を形成することができる。

[0049]

【発明の実施の形態】次に、図を参照しながら好ましい 具体的な例に基づき本発明を説明するが、本発明はこれ に限定されるものではない。

【0050】本発明においては、好ましくは、例えば前述の組成物のような樹脂を塗布することにより表面に凹凸形状を有する塗膜を基板上に形成し、その上に反射膜兼電極として金属薄膜を成膜すると、前記拡散反射性能に優れた凹凸形状を有する拡散反射電極を構成することができる。一方、反射膜兼電極を構成する代わりに別途電極を設けて、内面拡散反射板専用として金属薄膜を成膜することにより、同様に反射性能に優れた拡散反射板を構成することもできる。

【0051】この凹凸形状を有する平面としては、平面 方向にくり返しのないランダムなパターンの反射面を構 成するものである。この反射板を数10cm離して視認 した場合に、面内に均一な散乱性を呈すればよい。

【0052】その下方に形成される前記塗膜の凹凸形状を有する表面において、平面内の一方向における凹凸のピッチp が $0.5\sim10.0\mu$ mで、凹凸の段差の高さの平均h が $1.0\sim5.0\mu$ mであることが好ましい。前述のように本発明に使用する組成物による塗布方

法によれば容易にこの凹凸形状を形成することができる。凹凸のピッチの測定については、例えば走査型電子 顕微鏡により表面、断面を観察すればよいし、簡易的に は触針式段差計でも凹凸の様子を知ることができるし、 その他の適当な方法で測定すればよい。

10

【0053】図1は本発明の拡散反射電極を単純マトリクス型表示素子に形成した例の反射電極側基板の断面図である。基板1上に凹凸形状を有する塗膜3を樹脂の塗布により形成し、その上に金属薄膜による反射電極4を形成しその金属薄膜表面を凹凸形状として入射光を拡散反射させるように構成する。

【0054】図2はアクティブマトリクス基板1上に形成した例の断面図である。薄膜トランジスタ(TFT)を能動素子2として配置した基板を用いて、図1の場合と同様に凹凸形状を有する塗膜3形成後、能動素子2へのコンタクトホールを形成、金属薄膜による反射電極4を形成する。

【0055】以上の電極において、何れも(図1および 2)必要に応じ反射電極上に透明樹脂等を塗布し表面を 20 平坦化してもよい。

【0056】次に、本発明による凹凸形状を有する金属 薄膜を単に拡散反射板として用い、透明絶縁膜により平 坦化した上に、透明導電膜による画素電極を形成しても よい。このような拡散反射板を単純マトリクス用反射側 基板に適用した例を図3に、アクティブマトリクス用反 射側基板に適用した例を図4に、それぞれ示す。

【0057】本発明の拡散反射板はその反射面の凹凸形 状が拡散反射性能に優れ、従来から求められている凹凸 パターンが平面方向にくり返しのないランダムなパター ンを実質的に取得することができるため、例えば反射型 液晶表示素子に使用したときには容易に画面内均一な表 示の表示素子を形成することができる。

【0058】本発明の拡散反射板を表示素子、特に反射型液晶表示素子の内面拡散反射板として、特に拡散反射電極用の反射板として使用することができる。

【0059】本発明の内面拡散反射板が使用される表示素子については反射型であれば特に制限されず、液晶表示素子以外にもエレクトロクロミック表示素子等の受光型表示素子等への使用が可能である。

0 【0060】さらに、本発明の拡散反射板を有する反射型表示素子を使用した携帯情報端末、携帯通信端末等は視認性に優れている。

[0061]

30

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明を詳細に説明 する。

【0062】[例1:成分(a)の合成]

(a) 主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有するフッ素樹脂 の合成

ペルフルオロ (ブテニルビニルエーテル) 35g、イオン交換水150g、メタノール20gおよび重合開始剤





として ((CH₃)₂CHOCOO)₂ 90mgを、内容積200ccの耐圧ガラス製オートクレーブに入れ、 系内を3回窒素で置換した後、40℃で22時間懸濁重合を行ってポリマーAを28g得た。ポリマーAの固有 粘度 [η] は、ペルフルオロ (2ープチルテトラヒドロフラン) 中30℃で0.2d1/gであった。

11

【0063】[例2:成分(b)の合成]

(b) アルコキシシランの部分加水分解縮合物の合成 反応容器中で、テトラメトキシシランおよびCF₃ (CF₂)₅CH₂CH₂Si (OCH₃)₃をモル比1:0.5 の割合でメタノール中に溶解させ、さらに硝酸と水を加えた後に室温で72時間反応させることにより部分加水分解縮合物を合成した。この部分加水分解縮合物の重量 平均分子量は1,050 (GPCにより求めた標準ポリスチレン換算値)であった。次いで、反応液をイオン交換樹脂塔内を通過させることにより硝酸を除去した後、溶剤置換を行い、部分加水分解縮合物(以下縮合物Bという)のペルフルオロトリブチルアミンとCF₃CF₂CH₂OHの混合溶剤(重量比95:5)溶液を得た。縮合物Bの溶液中での固形分濃度は9重量%であった。

【0064】[例3:調合および塗布]

(a)、(b)混合溶液の調製

例1で得られたポリマーAおよび例2で得られた縮合物 Bより、A対Bの組成比が異なる溶液を調製した。この とき、溶液の固形分濃度および溶剤組成を下記とした。 【0065】AとBを合わせた全固形分濃度が9重量 %。

ペルフルオロトリプチルアミン: $CF_3CF_2CH_2OH$ = 90:10 (重量比)。

【0066】混合溶液を、スピンコートにて回転数600RPMでガラス基板上に塗布し、その後、ホットプレート上80℃で90秒間、さらに電気炉にて350℃で1時間加熱して完全に硬化させた。硬化後の樹脂膜の膜厚は約2~4 μ mのランダムな凹凸形状になった。基板の平面内の一方向における凹凸のピッチp は、走査型電子顕微鏡による表面観察の結果、2~3 μ mであり、凹凸の段差の高さの平均p は、触針式段差計で測定した結果、3~4 μ mであった。

【0067】その上にスパッタリング法により120nm厚のAI膜を形成し、正規反射率を測定すると、例えば、A対Bが80対20の場合、集光角8°で31%、集光角2°で11%であった。A対Bが40対60の場合は、集光角8°で23%、集光角2°で0.4%であった。ポリマーAに対して縮合物Bの割合を大きくすることでより大きな凹凸形状を形成する方向に膜表面の形状を制御することができた。

【0068】[例4:拡散反射電極の製造-1]図1に示すような構成の単純マトリクス型表示素子用の反射電極側基板を製造した。ガラス基板(基板1)上に、例3で得られた成分A対Bが40対60の溶液を、スピンコー

トにて回転数 600RPMで全面に塗布した。その後、ホットプレート上80℃で90秒間、さらに電気炉にて350℃で1時間加熱して完全に硬化させた。硬化後の樹脂膜(塗膜 3)の膜厚は約 $2\sim4\mu$ mのランダムな凹凸形状になった。次いで、スパッタリング法により 120 n m厚の A1 膜を形成し、パターニングし反射電極 4 とした。 A1 膜のエッチングは硝酸、酢酸および燐酸の混合液により行った。良好な拡散反射性能を持った拡散反射電極が得られた。

【0069】[例5:拡散反射電極の製造-2]図2に示 すような構成のアクティブマトリクス型表示用の反射電 極側基板を製造した。オフセットゲートコプレーナ構造 多結晶シリコンTFTを画素駆動素子(能動素子2)と して用いたアクティブマトリクス基板(基板1)上に、 例3で得られたA対Bが40対60の溶液を、スピンコ ートにて回転数600RPMで全面に塗布した。その 後、ホットプレート上80℃で90秒間、さらに電気炉 にて350℃で1時間加熱して完全に硬化させた。硬化 後の樹脂膜(塗膜3)の膜厚は約2~4μmのランダム 20 な凹凸形状になった。次いで、30秒間の窒素プラズマ 処理後、フォトレジスト(東京応化製OFPR800) を塗布、露光、現像しコンタクトホールのパターンを形 成する。 CF₄/O2プラズマにより塗布膜をドライエ ッチし、フォトレジストを剥離液(東京応化製502 A) により剥離した。TMAH2. 4%水溶液でポリマ 一残滓を洗浄後、スパッタリング法により120nm厚 のA1膜を形成し、パターニングし反射電極4とした。 A1膜のエッチングは硝酸、酢酸および燐酸の混合液に より行った。良好な拡散反射性能を持った拡散反射電極 30 が得られた。

【0070】[例6:内面拡散反射板付単純マトリクス 用反射側基板の製造]図3に示すような構成の内面拡散 反射板付単純マトリクス用反射側基板を製造した。ガラ ス基板(基板1)上に、前記例3の実施例に従い調合し て得られたA対Bが30対70の溶液を、スピンコート にて回転数600RPMで全面に塗布した。その後、ホ ットプレート上80℃で90秒間、さらに電気炉にて3 50℃で1時間加熱して完全に硬化させた。硬化後の樹 脂膜(塗膜3)の膜厚は約2~4μmのランダムな凹凸 形状になった。次いで、スパッタリング法により120 nm厚のA1膜を形成し、拡散反射板5とした。エポキ シ系平坦化膜6 (新日鐵化学(株) 製V259EH)を 塗布、加熱硬化させた。硬化後の平坦化膜の膜厚は約3 ~5 μ m であり、表面の凹凸は±0.2 μ m程度、凹凸 のピッチは2~3μmであった。その上に、スパッタリ ング法により50nm厚のITO膜を形成し、パターニ ングし、透明電極7を形成した。良好な拡散反射性能と 平坦性を兼ね備えた内面拡散反射板付単純マトリクス用 反射側基板が得られた。

【0071】[例7:内面拡散反射板付アクティブマト

50



13

リクス基板の製造]図4に基づいて、内面拡散反射板付アクティブマトリクス基板を製造した。ガラス基板(基板1)上に、例6と同様に凹凸膜、内面拡散反射A1膜および平坦化膜を積層した。その上に、逆スタガー型アモルファスシリコンTFT8を画素駆動素子としたアクティブマトリクスを形成、画素電極9はITO膜により形成した。良好な拡散反射性能と平坦性を兼ね備えた内面拡散反射板付アクティブマトリクス基板が得られた。

[0072]

【発明の効果】本発明の拡散反射板はその反射面に必要な優れた反射性能を有する凹凸形状を有し、しかもその凹凸形状が単なる塗膜形成で得られるため、例えば容易に画面内均一な表示の反射型液晶表示素子を形成することができる。特に、本発明に使用する組成物の塗布により形成される樹脂塗膜はその組成比の調整により凹凸の大小を制御することができ、また1回の塗布で基板面内に優れた凹凸形状面を形成することができるため、素子設計も製造も容易であり、高い生産性でこれらを製造することができる。

【0073】さらに、この方法によれば、光の拡散面が セルの内面にあるため、基板の厚みによる視差の影響を 受けることがなく、例えば高精細な反射型液晶表示素子 を実現することができ、表示素子用の拡散反射板、特に 拡散反射電極に好適に適用できる拡散反射板として極め て優れている。

14

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で得られる拡散反射電極を単純マトリクス型表示素子に形成した例の反射電極側基板の断面図。

0 【図2】本発明で得られる拡散反射電極付き基板(アクティブマトリクスの例)の例の断面図。

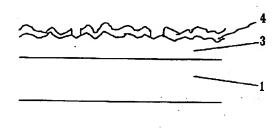
【図3】本発明の拡散反射板を単純マトリクス用反射側 基板に適用した例の断面図。

【図4】本発明の拡散反射板をアクティブマトリクス用 反射側基板に適用した例の断面図。

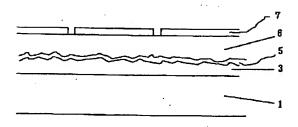
【符号の説明】

1:基板;2:能動素子;3:塗膜;4:反射電極;5:拡散反射板;6:平坦化膜;7:透明電極;8:TFT;9:画素電極

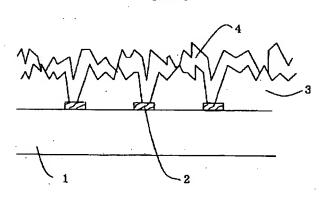
【図1】



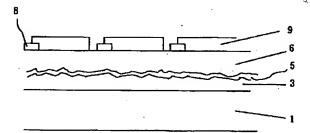
【図3】



【図2】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 横塚 俊亮

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社内 THIS PAGE BLANK (USPTO)